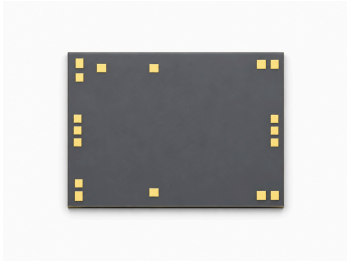


Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 13000–15000 MHz

pulsado: PSAT: 42 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (típico); PAE: 35 % (mínimo) / 37 % (típico). Dimensiones del die: 2.8 × 2 × 0.1 mm.



Características RF · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; pulsado

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	13000	-	15000	13000–15000	MHz
Potencia de salida saturada	Psat	-	42	-	-	dBm
Ganancia de potencia	Gp	-	21	-	-	dB
Planitud de la ganancia de potencia	ΔGp	-	±0.35	-	-	dB
Eficiencia de potencia añadida	PAE	35	37	-	-	%
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.8	-	-	-

Polarización DC y corrientes · TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de drenador	Vd	24	28	32	V
Tensión de puerta	Vg	-5	-3.05	-2.6	V
Corriente de drenador en reposo	Id	-	0.11	-	A
Corriente dinámica de drenador	Idd	-	1.7	-	A
Corriente dinámica de puerta	Igg	-	0.5	-	mA

Valores límite

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	Vd	-	-	32	V
Polarización de puerta mínima	Vg	-5	-	-	V
Potencia de entrada máxima	Pin	-	-	24	dBm
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-65	-	150	°C
Temperatura máxima del canal	Top	-	-	225	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	2.8 × 2 × 0.1	mm

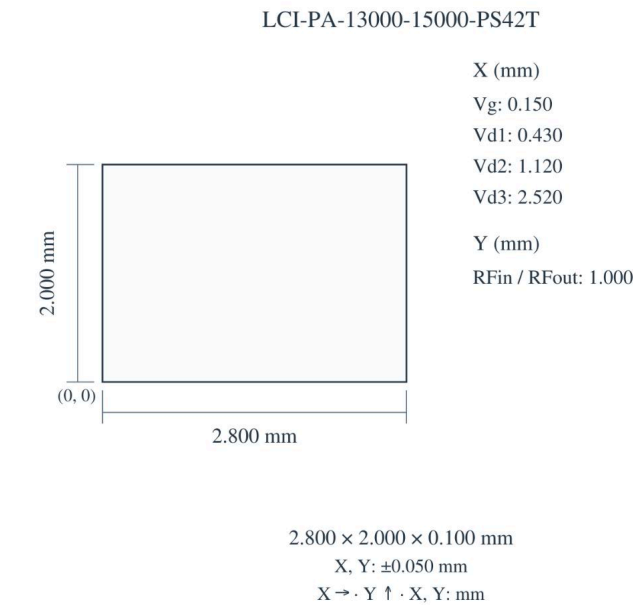
Integración del chip y secuencia de polarización

Bloqueo DC integrado: RFin / RFout. Trayecto DC a masa: RFin → GND. Caracterización independiente: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW; Pin = 21 dBm. Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador. Se recomienda alimentar la polarización por ambos lados.

Alcance de la referencia mecánica

Contorno y referencias de coordenadas acotadas según la fuente, en mm. No constituye un plano completo de fabricación ni de conexionado por hilo.

Plano dimensional mecánico



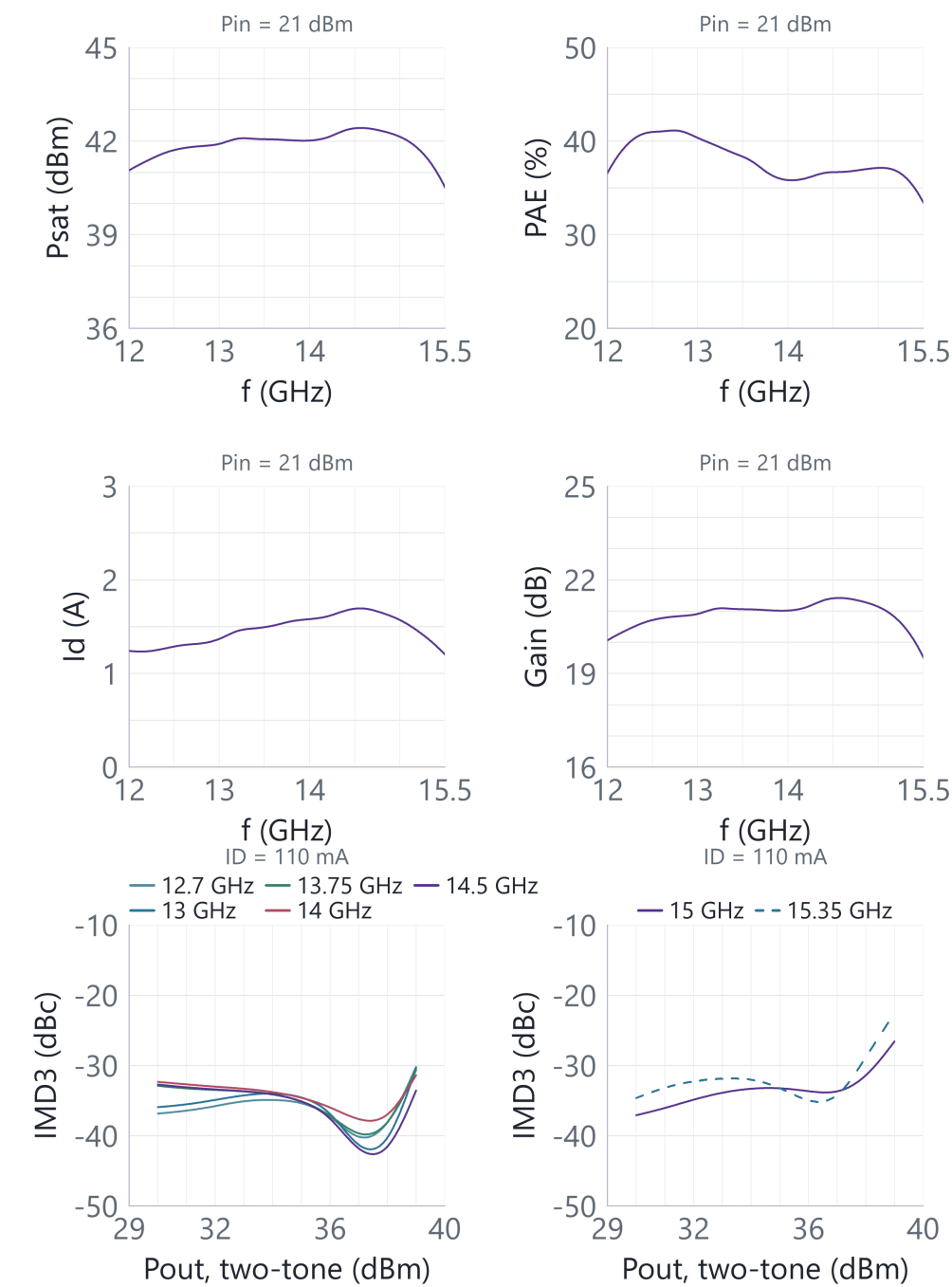
Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Curvas de rendimiento

Gráficas de la hoja de datos original. Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador; Ganancia de potencia; IMD3.

Anotación de la página original: Vd=+28V; Vg=-3.05V. Gráfico redibujado a partir de la figura original; las lecturas son aproximadas. Psat/PAE/Id/ Gain: Pin = 21 dBm. IMD3: Id = 110 mA.



Fuente

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.